

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

平成 12 年 5 月 26 日

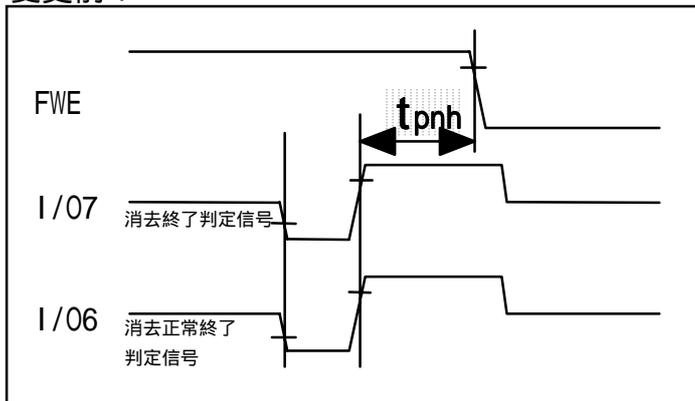
日立マイクロコンピュータ技術情報

〒100-0004
 東京都千代田区大手町2丁目6番2号
 (日本ビル)
 TEL (03)5201-5191 (ダイヤルイン)
 株式会社 日立製作所 半導体グループ

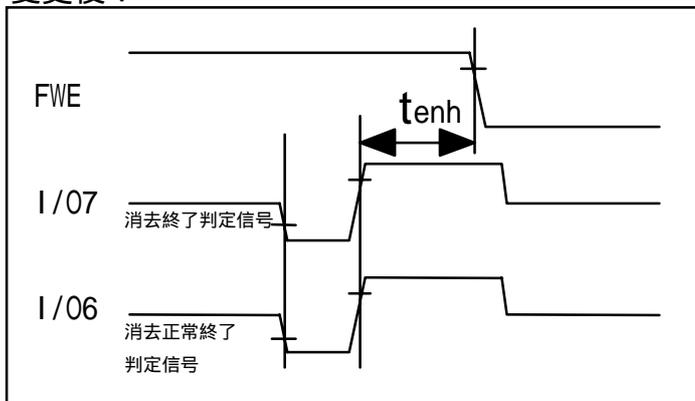
題 目	SH7055F ハードウェアマニュアル 記号、DC 特性、端子名の訂正		発行番号	TN-SH7-238A	
			分 類	1. 仕様変更 ②. ドキュメント訂正追加等 3. 使用上の注意事	
適 用 製 品	HD64F7055R	対象ロット等	SH7055F-ZTAT ハードウェア マニュアル	Rev.	有効期限
		全ロット		関連資料	第3版

SH7055F ハードウェアマニュアルにおいて、AC スペックの記号、DC 特性、端子名の記述に誤りがあるため訂正致します。

P.845 図 22.26 自動消去モードのタイミング波形
変更前：



変更後：



P.875,876 表 5.4 DC 特性

変更前 :

項目	記号	min	typ	max	単位	測定条件
入力ハイレベル電圧 (シュミットトリガ入力 端子を除く)	/RES、NMI、FWE、MD2~0、/HSTBY	V _{IH}	V _{CC} -0.5	-	PV _{CC} +0.3	V PV _{CC} =3.0V ~ 5.5V
	D15~D0、/WAIT、/BREQ(メモリ外部拡張時)	V _{IH}	2.2	-	PV _{CC} +0.3	V PV _{CC} =3.3V±0.3V
入力リーク電流	D15~D0、/WAIT、/BREQ(メモリ外部拡張時) PV _{CC} =3.3±0.3V	I _{in}	-	-	1.0	μA V _{in} =0.5~PV _{CC} -0.5V
スリーステートリーク 電流(オフ状態)	A21~A0、D15~D0、/CS3~/CS0、/WRH、 /WRL、/RD(メモリ外部拡張時)PV _{CC} =3.3± 0.3V	I _{ts}	(プルアップ 特性)	-	1.0	μA V _{in} =0.5~PV _{CC} -0.5V
出力ハイレベル電圧	A21~A0、D15~D0、/CS3~/CS0、/WRH、 /WRL、/RD、(メモリ外部拡張時)PV _{CC} =3.3± 0.3V	V _{OH}	PV _{CC} -0.5	-	-	V I _{OH} =200 μA
出力ローレベル電圧	A21~A0、D15~D0、/CS3~/CS0、/WRH、 /WRL、/RD、/BACK(メモリ外部拡張時のみ) PV _{CC} =3.3±0.3V	V _{OL}	-	-	0.4	V I _{OL} =1.6mA
基準電源電流	スタンバイ時	A _{Iref}	-	1.1	5	μA

変更後 :

項目	記号	min	typ	max	単位	測定条件
入力ハイレベル電圧 (シュミットトリガ入力 端子を除く)	/RES、NMI、FWE、MD2~0、/HSTBY	V _{IH}	V _{CC} -0.5	-	5.8	V PV _{CC} =3.0V ~ 5.5V
	D15~D0、/WAIT、/BREQ(MCU 拡張モード 時)	V _{IH}	2.2	-	PV _{CC} +0.3	V PV _{CC} =3.3V±0.3V
入力リーク電流	D15~D0、/WAIT、/BREQ(MCU 拡張モード 時)	I _{in}	-	-	1.0	μA V _{in} =0.5~PV _{CC} -0.5V PV _{CC} =3.3V±0.3V
スリーステートリーク 電流(オフ状態)	A21~A0、D15~D0、/CS3~/CS0、/WRH、 /WRL、/RD、/BACK(MCU 拡張モード時)	I _{ts}	-	-	1.0	μA V _{in} =0.5~PV _{CC} -0.5V PV _{CC} =3.3V±0.3V
出力ハイレベル電圧	A21~A0、D15~D0、/CS3~/CS0、/WRH、 /WRL、/RD、/BACK(MCU 拡張モード時)	V _{OH}	PV _{CC} -0.5	-	-	V I _{OH} =200 μA PV _{CC} =3.3V±0.3V
出力ローレベル電圧	A21~A0、D15~D0、/CS3~/CS0、/WRH、 /WRL、/RD、/BACK(MCU 拡張モード時)	V _{OL}	-	-	0.4	V I _{OL} =1.6mA PV _{CC} =3.3V±0.3V
基準電源電流	スタンバイ時	A _{Iref}	-	1.1	5	μA A _{Vref} =5V

追加 :

項目	記号	min	typ	max	単位	測定条件
入力ハイレベル電圧 (シュミットトリガ入力 端子を除く)	PE15~PE0、PF15~PF0、PH15~PH0(MCU 拡張モード時)	V _{IH}	2.2	-	PV _{CC} +0.3	V PV _{CC} =3.3V±0.3V
入力リーク電流	PE15~PE0、PF15~PF0、PH15~PH0(MCU 拡張モード時)	I _{in}	-	-	1.0	μA V _{in} =0.5~PV _{CC} -0.5V PV _{CC} =3.3V±0.3V
出力ハイレベル電圧	PE15~PE0、PF15~PF0、PH15~PH0(MCU 拡張モード時)	V _{OH}	PV _{CC} -0.5	-	-	V I _{OH} =200 μA PV _{CC} =3.3V±0.3V
出力ローレベル電圧	PE15~PE0、PF15~PF0、PH15~PH0(MCU 拡張モード時)	V _{OL}	-	-	0.4	V I _{OL} =1.6mA PV _{CC} =3.3V±0.3V

P.899 図 25.24 ブランチトレース時タイミング



P.899 図 25.25 RAM モニタ時タイミング

